



# TT100N120PF1E

## 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

I <sub>c</sub>	100A
V <sub>CEs</sub>	1200V
V <sub>cesat_typ</sub> (V <sub>ge</sub> =15V)	1.9V

### 用途

- 辅助逆变器
- 电机传动
- 空调

### APPLICATIONS

- Auxiliary inverter
- Motor Drives
- air conditioning

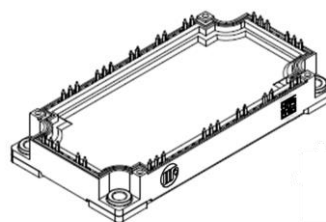
### 产品特性

- FS 技术
- VCEsat 正温度系数
- 低开关损耗

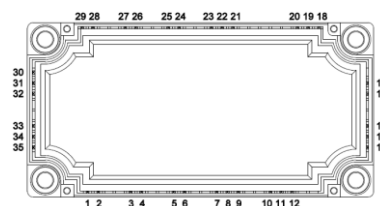
### FEATURES

- FS Technology
- VCEsat with positive Temperature Coefficient
- Low Switching Losses

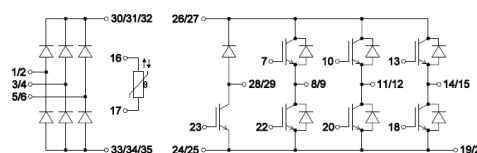
## 封装 Package



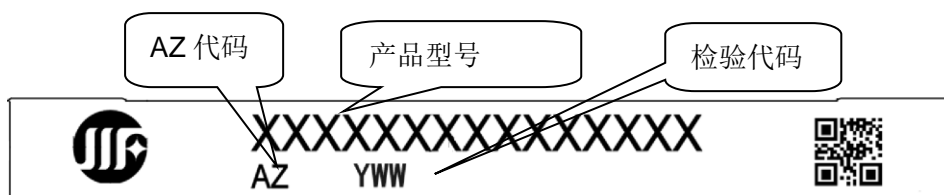
外形示意图



引脚示意图



电路示意图



产品型号说明（具体位数由产品决定）：产品类型（1位）+工艺平台（1位）+电流（3位）+频率（1位）+电压（3位）+电路拓扑（1位）+封装外形（1位）+特殊工艺（1位）+芯片版本（1位）。

AZ 代码说明：A 代表芯片代码，Z 代表封装厂代码；

检验代码说明：Y(年代码，执行内部定义)+WW（周代码）

## 订货信息 ORDER MESSAGE

订货型号 Order codes	印记 Marking	封装 Package	包装 Packaging	器件重量 Device Weight
TT100N120PF1E	TT100N120PF1E	PF1	盒装	300g(typ)

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )

## IGBT, 逆变器/ IGBT, Inverter

项 目 Parameter	条件	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最高集电极—发射极直流电压 Collector-Emmitter Voltage	$T_{vj}=25^\circ\text{C}$	$V_{CE}$	1200	V
连续集电极极电流 Collector Current-continuous	$T_c=95^\circ\text{C}, T_{vj}=175^\circ\text{C}$	$I_C$	100	A
最大脉冲集电极极电流 (注 1) Collector Current – pulse (note 1)	$t_P = 1 \text{ ms}$	$I_{CM}$	200	A
最高栅极发射极电压 Gate-Emmitter Voltage		$V_{GE}$	$\pm 20$	V
短路时间 short circuit time		$t_{sc}$	10	$\mu\text{s}$
耗散功率 Power Dissipation	$T_c=25^\circ\text{C}, T_{vj}=175^\circ\text{C}$	$P_D$	515	W
结温范围 JunctionTemperature		$T_{vjmax}$	175	°C
		$T_{vjop}$	-40~+150	

## IGBT, 斩波制动/IGBT, Brake-Chopper

项 目 Parameter	条件	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
最高集电极—发射极直流电压 Collector-Emmitter Voltage	$T_{vj}=25^\circ\text{C}$	$V_{CE}$	1200	V
连续集电极极电流 Collector Current-continuous	$T_c=95^\circ\text{C}, T_{vj}=175^\circ\text{C}$	$I_C$	50	A
最大脉冲集电极极电流 (注 1) Collector Current – pulse (note 1)	$t_P = 1 \text{ ms}$	$I_{CM}$	100	A
最高栅极发射极电压 Gate-Emmitter Voltage		$V_{GE}$	$\pm 20$	V
短路时间 short circuit time		$t_{sc}$	10	$\mu\text{s}$
耗散功率 Power Dissipation	$T_c=25^\circ\text{C}, T_{vj}=175^\circ\text{C}$	$P_D$	280	W
结温范围 JunctionTemperature		$T_{vjmax}$	175	°C
		$T_{vjop}$	-40~+150	



绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )

## 二极管, 逆变器/FRD, Inverter

项 目 Parameter	条件	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{RRM}$	1200	V
连续正向直流电流 Continuous DC forward current		$I_F$	100	A
正向重复峰值电流 Repetitive peak forward current	$t_p = 1 \text{ ms}$	$I_{FRM}$	200	A
$I^2t$ -值 $I^2t$ value	$V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	$I^2t$	1550	$\text{A}^2\text{S}$

## 二极管, 斩波制动/IGBT, Brake-Chopper

项 目 Parameter	条件	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{RRM}$	1200	V
连续正向直流电流 Continuous DC forward current		$I_F$	25	A
正向重复峰值电流 Repetitive peak forward current	$t_p = 1 \text{ ms}$	$I_{FRM}$	50	A
$I^2t$ -值 $I^2t$ value	$V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	$I^2t$	90	$\text{A}^2\text{S}$

## 二极管, 整流器/Diode, Rectifier

项 目 Parameter	条件	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{RRM}$	1600	V
最大正向均方根电流(每芯片) Maximum RMS forward current per chip	$T_c=80^\circ\text{C}$	$I_{FRMSM}$	80	A
最大整流器输出均方根电流 Maximum RMS current at rectifier output	$T_c=80^\circ\text{C}$	$I_{RMSM}$	140	A
正向浪涌电流 Surge forward current	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	600 470	A
$I^2t$ -值 $I^2t$ value	$V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$I^2t$	1800	$\text{A}^2\text{S}$





## 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

## IGBT, 逆变器/ IGBT, Inverter

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
<b>关态特性 Off –Characteristics</b>						
集电极—发射极击穿电压 Collector-Emmitter Voltage	$BV_{CES}$	$I_C=1mA, V_{GE}=0V$	1200	-	-	V
零栅压下集电极漏电流 Zero Gate Voltage Collector Current	$I_{CES}$	$V_{CE}=1200V, V_{GE}=0V, T_C=25^\circ C$	-	-	1	mA
正向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, forward	$I_{GESF}$	$V_{CE}=0V, V_{GE}=20V$	-	-	150	nA
反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, reverse	$I_{GESR}$	$V_{CE}=0V, V_{GE}=-20V$	-	-	-150	nA
<b>通态特性 On-Characteristics</b>						
阈值电压 Gate-Emmitter Threshold Voltage	$V_{GE(th)}$	$V_{CE} = V_{GE}, I_C=2.8mA$	5.2	5.85	6.5	V
饱和压降 Collector-Emmitter saturation Voltage	$V_{CESAT}$	$V_{GE}=15V, I_C=100A$ $T_C=25^\circ C$ $T_C=150^\circ C$	- - -	1.9 2.25	2.4 -	V
短路电流（注2） Short Collector current（Note 2）	$I_{C(SC)}$	$V_{GE}=15V, V_{CE}=600V, t_{SC} < 10\mu s, T_C=25^\circ C$		450		A
<b>动态特性 Dynamic Characteristics</b>						
输入电容 Input capacitance	$C_{ies}$	$V_{CE}=25V, V_{GE}=0V,$ $f=1.0MHz$	-	10.5		nF
输出电容 Output capacitance	$C_{oes}$		-	0.7		nF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	$C_{res}$		-	0.16		nF



## 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

## IGBT, 逆变器/IGBT, Inverter

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
<b>开关特性 Switching Characteristics</b>						
开启延迟时间 Turn-On delay time	$t_d(\text{on})$	$V_{CE}=600V,$ $I_c=100A,$ $V_{GE}=15V,$ $R_G=15\Omega,$ 感性负载	$T_C=25^\circ\text{C}$	118		ns
上升时间 Turn-On rise time	$t_r$		$T_C=25^\circ\text{C}$	63		ns
关断延迟时间 Turn-Off delay time	$t_d(\text{off})$		$T_C=25^\circ\text{C}$	180		ns
下降时间 Turn-Off Fall time	$t_f$		$T_C=25^\circ\text{C}$	108		ns
开通损耗 Turn-On energy	$E_{on}$		$T_C=25^\circ\text{C}$	4		mJ
关断损耗 Turn-off energy	$E_{off}$		$T_C=25^\circ\text{C}$	8		mJ
总开关损耗 Total switching energy	$E_{tot}$		$T_C=25^\circ\text{C}$	12		mJ
开启延迟时间 Turn-On delay time	$t_d(\text{on})$	$V_{CE}=600V,$ $I_c=75A,$ $V_{GE}=15V,$ $R_G=15\Omega,$ 感性负载	$T_C=150^\circ\text{C}$	120		ns
上升时间 Turn-On rise time	$t_r$		$T_C=150^\circ\text{C}$	69		ns
关断延迟时间 Turn-Off delay time	$t_d(\text{off})$		$T_C=150^\circ\text{C}$	260		ns
下降时间 Turn-Off Fall time	$t_f$		$T_C=150^\circ\text{C}$	230		ns
开通损耗 Turn-On energy	$E_{on}$		$T_C=150^\circ\text{C}$	6		mJ
关断损耗 Turn-off energy	$E_{off}$		$T_C=150^\circ\text{C}$	12		mJ
总开关损耗 Total switching energy	$E_{tot}$		$T_C=150^\circ\text{C}$	18		mJ
栅极电荷总量 Total Gate Charge	$Q_g$	$V_{GE}=-15V \dots +15V$	-	450	-	nC
内部栅极电阻 Internal gate resistance	$R_{Gint}$	$f=1\text{ MHz, open collector}$		1.8		$\Omega$
结-外壳热阻 Thermal resistance junction to case	$R_{thJC}$	每个IGBT per IGBT			0.29	K/W
外壳-散热器热阻 Thermal resistance case to heatsink	$R_{thCH}$	每个IGBT per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) /$ $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.13		K/W
开关下的温度 Temperature under switching conditions	$T_{vjop}$		-40		150	$^\circ\text{C}$





## 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

## IGBT 斩波制动/ IGBT Brake-Chopper

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
<b>关态特性 Off-Characteristics</b>						
集电极-发射极击穿电压 Collector-Emmitter Voltage	$BV_{CES}$	$I_C=1mA, V_{GE}=0V$	1200	-	-	V
零栅压下集电极漏电流 Zero Gate Voltage Collector Current	$I_{CES}$	$V_{CE}=1200V, V_{GE}=0V, T_C=25^\circ C$	-	-	1	mA
正向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, forward	$I_{GESF}$	$V_{CE}=0V, V_{GE}=20V$	-	-	100	nA
反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, reverse	$I_{GESR}$	$V_{CE}=0V, V_{GE}=-20V$	-	-	-100	nA
<b>通态特性 On-Characteristics</b>						
阈值电压 Gate-Emmitter Threshold Voltage	$V_{GE(th)}$	$V_{CE} = V_{GE}, I_C=1.6mA$	5.2	5.85	6.5	V
饱和压降 Collector-Emmitter saturation Voltage	$V_{CESAT}$	$V_{GE}=15V, I_C=50A$ $T_C=25^\circ C$ $T_C=150^\circ C$	- - -	1.9 2.3	2.3 -	V
短路电流 (注2) Short Collector current (Note 2)	$I_{C(SC)}$	$V_{GE}=15V, V_{CE}=600V, t_{SC} < 10\mu s, T_C=25^\circ C$		235		A
<b>动态特性 Dynamic Characteristics</b>						
输入电容 Input capacitance	$C_{ies}$	$V_{CE}=25V, V_{GE}=0V, f=1.0MHz$	-	5.8		nF
输出电容 Output capacitance	$C_{oes}$		-	0.26		nF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	$C_{res}$		-	0.07		nF





## 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

## IGBT 斩波制动/ IGBT Brake-Chopper

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
<b>开关特性 Switching Characteristics</b>						
开启延迟时间 Turn-On delay time	$t_{d(on)}$	$V_{CE}=600V,$ $I_c=50A,$	$T_C=25^\circ C$	92		ns
上升时间 Turn-On rise time	$t_r$		$T_C=25^\circ C$	60		ns
关断延迟时间 Turn-Off delay time	$t_{d(off)}$	$V_{GE}=15V,$ $R_G=15\Omega,$	$T_C=25^\circ C$	128		ns
下降时间 Turn-Off Fall time	$t_f$		$T_C=25^\circ C$	191		ns
开通损耗 Turn-On energy	$E_{on}$	感性负载	$T_C=25^\circ C$	4.8		mJ
关断损耗 Turn-off energy	$E_{off}$		$T_C=25^\circ C$	2.1		mJ
总开关损耗 Total switching energy	$E_{tot}$		$T_C=25^\circ C$	6.9		mJ
开启延迟时间 Turn-On delay time	$t_{d(on)}$	$V_{CE}=600V,$ $I_c=50A,$	$T_C=150^\circ C$	98		ns
上升时间 Turn-On rise time	$t_r$		$T_C=150^\circ C$	70		ns
关断延迟时间 Turn-Off delay time	$t_{d(off)}$	$V_{GE}=15V,$ $R_G=15\Omega,$	$T_C=150^\circ C$	174		ns
下降时间 Turn-Off Fall time	$t_f$		$T_C=150^\circ C$	280		ns
开通损耗 Turn-On energy	$E_{on}$	感性负载	$T_C=150^\circ C$	6.1		mJ
关断损耗 Turn-off energy	$E_{off}$		$T_C=150^\circ C$	3.1		mJ
总开关损耗 Total switching energy	$E_{tot}$		$T_C=150^\circ C$	12.2		mJ
栅极电荷总量 Total Gate Charge	$Q_g$	$V_{GE}=-15V \dots +15V$	-	200	-	nC
内部栅极电阻 Internal gate resistance	$R_{Gint}$	$f=1\text{ MHz, open collector}$		7		$\Omega$
结—外壳热阻 Thermal resistance junction to case	$R_{thJC}$	每个IGBT per IGBT			0.54	K/W
外壳—散热器热阻 Thermal resistance case to heatsink	$R_{thCH}$	每个IGBT per IGBT $\lambda_{Paste} = 1\text{ W/(m}\cdot\text{K)} /$ $\lambda_{grease} = 1\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		0.25		K/W
开关下的温度 Temperature under switching conditions	$T_{vjop}$		-40		150	$^\circ C$





## 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

## 二极管, 逆变器/FRD, Inverter

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
<b>二极管特性 Diode Characteristics</b>						
正向压降 Diode Forward Voltage	$V_F$	$V_{GE}=0V, I_F=100A,$ $TC=25^{\circ}C$	-	1.8	2.2	V
		$V_{GE}=0V, I_F=100A,$ $TC=150^{\circ}C$	-	1.6	-	V
反向恢复时间 Diode Reverse recovery time	$t_{rr}$	$I_F = 100 A, - diF/dt =$ $660 A/\mu s (T_{vj}=25^{\circ}C)$ $VR = 600 V$ $V_{GE} = -15 V$	-	220	-	ns
反向恢复电荷 Diode Reverse recovery charge	$Q_{rr}$		-	10	-	$\mu C$
反向恢复电流 Diode Reverse recovery Current	$I_{RRM}$		-	85	-	A
反向恢复损耗（每脉冲） Reverse recovery energy	$E_{rec}$				3.1	mJ
反向恢复时间 Diode Reverse recovery time	$t_{rr}$		-	370	-	ns
反向恢复电荷 Diode Reverse recovery charge	$Q_{rr}$	$I_F = 100A, - diF/dt = 660$ $A/\mu s (T_{vj}=150^{\circ}C)$ $VR = 600 V$ $V_{GE} = -15 V$	-	16	-	$\mu C$
反向恢复电流 Diode Reverse recovery Current	$I_{RRM}$		-	86	-	A
反向恢复损耗（每脉冲） Reverse recovery energy	$E_{rec}$				6.5	mJ
结—外壳热阻 Thermal resistance junction to case	$R_{thJC}$		每个二极管 per diode			0.5
外壳—散热器热阻 Thermal resistance case to heatsink	$R_{thCH}$	每个二极管 per diode $\lambda_{Paste} = 1 W/(m \cdot K) /$ $\lambda_{grease} = 1 W/(m \cdot K)$		0.23		K/W
开关下的温度 Temperature under switching conditions	$T_{vjop}$		-40		150	$^{\circ}C$







## 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

## 二极管, 斩波制动/ FRD Brake-Chopper

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
<b>二极管特性 Diode Characteristics</b>						
正向压降 Diode Forward Voltage	$V_F$	$V_{GE}=0V, I_F=50A,$ $TC=25^{\circ}C$	-	1.9	2.15	V
		$V_{GE}=0V, I_F=50A,$ $TC=150^{\circ}C$	-	1.7	-	V
反向恢复时间 Diode Reverse recovery time	$t_{rr}$	$V_{GE}=0V, V_R=600V$ $I_F=50A$ $dI_F/dt=900A/\mu s$ $TC=25^{\circ}C$	-	358	-	ns
反向恢复电荷 Diode Reverse recovery charge	$Q_{rr}$		-	4860	-	nC
反向恢复电流 Diode Reverse recovery Current	$I_{RRM}$		-	36	-	A
反向恢复损耗 (每脉冲) Reverse recovery energy	$E_{rec}$		-	1.7	-	mJ
反向恢复时间 Diode Reverse recovery time	$t_{rr}$	$V_{GE}=0V, V_R=600V$ $I_F=50A$ $dI_F/dt=900A/\mu s$ $TC=150^{\circ}C$	-	520	-	ns
反向恢复电荷 Diode Reverse recovery charge	$Q_{rr}$		-	7100	-	nC
反向恢复电流 Diode Reverse recovery Current	$I_{RRM}$		-	38	-	A
反向恢复损耗 (每脉冲) Reverse recovery energy	$E_{rec}$		-	1.7	-	mJ
结-外壳热阻 Thermal resistance junction to case	$R_{thJC}$	每个二极管 per diode			1.35	K/W
外壳-散热器热阻 Thermal resistance case to heatsink	$R_{thCH}$	每个二极管 per diode $\lambda_{Paste} = 1 W/(m \cdot K)$ / $\lambda_{grease} = 1 W/(m \cdot K)$		0.6		K/W
开关下的温度 Temperature under switching conditions	$T_{vjop}$		-40		150	$^{\circ}C$





## 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

## 二极管, 整流器/Diode, Rectifier

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
二极管特性 Diode Characteristics						
正向压降 (芯片) Diode Forward Voltage	$V_F$	$V_{GE}=0V, I_F=100A$	-	1.2	-	V
反向电流 Reverse current	$I_R$	$T_{vj} = 150^{\circ}C,$ $V_R = 1600 V$		1		mA
结-外壳热阻 Thermal resistance junction to case	$R_{thJC}$	每个二极管 per diode			0.45	K/W
外壳-散热器热阻 Thermal resistance case to heatsink	$R_{thCH}$	每个二极管 per diode $\lambda_{Paste} = 1 W/(m \cdot K) /$ $\lambda_{grease} = 1 W/(m \cdot K)$		0.2		K/W

## 负温度系数热敏电阻/NTC-Thermistor

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit	
额定电阻值 Rated resistance	$R_{25^{\circ}C}$	4.75	5	5.25	kohm	
时间常数 静止空气中	$\tau$	-	-	10	Sec	
最大额定功率	$P_{max}$	-	-	10	mW	
B-值 B-value	$B = [(T_a \times T_b) / (T_b - T_a)] \times \ln(R_a / R_b)$ $T_b = 50^{\circ}C \pm 0.01^{\circ}C$	$B_{25/50}$	3346.2	3380	3413.8	K
工作温度	-	-50	-	200	$^{\circ}C$	

注释:

- 1: 脉冲宽度由最高结温限制
- 2: 两次短路之间的间隔大于 1 秒时, 允许短路测试的次数最大为 1000 次

Notes:

- 1: Pulse width limited by maximum junction temperature
- 2: Allowed number of short circuits: <1000; time between short circuits: >1s.





## 模块特性/Module Characteristics

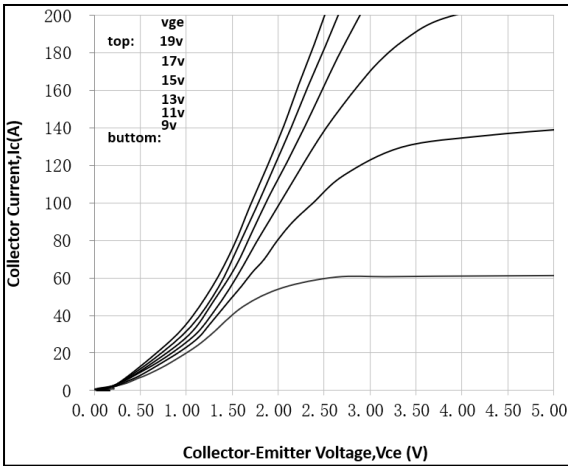
项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 Min	典型 Typ	最大 Max	单位 Unit
绝缘测试电压 Isolation test voltage	V <sub>ISOL</sub>	RMS, f = 50 Hz, t = 1min		2.5		KV
模块基板材料 Material of module baseplate	Cu					
内部绝缘 Internal isolation	基本绝缘 (class 1, IEC 61140) Basic insulation (class1, IEC 61140)		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>			
爬电距离 Creepage distance		端子-散热片 terminal to heatsink	-	10	-	mm
		端子-端子 Terminal to terminal	-	10	-	
电气间隙 Clearance		端子-散热片 terminal to heatsink	-	7.5	-	mm
		端子-端子 Terminal to terminal	-	7.5	-	
相对电痕指数 Comperative tracking index	CT1		200			
杂散电感,模块 Stray inductance module	L <sub>sCE</sub>			40		nH
模块引线电阻,端子-芯片 Module lead resistance terminals chip	R <sub>CC'+EE'</sub>			4		mΩ
储存温度 Storage temperature	T <sub>stg</sub>		-40		125	°C
安装扭矩 Mounting torque for modul mounting	M	螺丝 M5 根据相应的 应用手册进行安装 Screw M5 - Mounting according to valid application note	3		6	Nm
重量 Weight	G		-	300	-	g



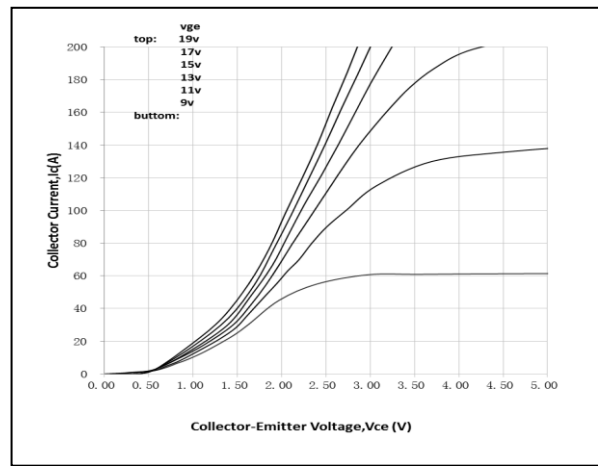


特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

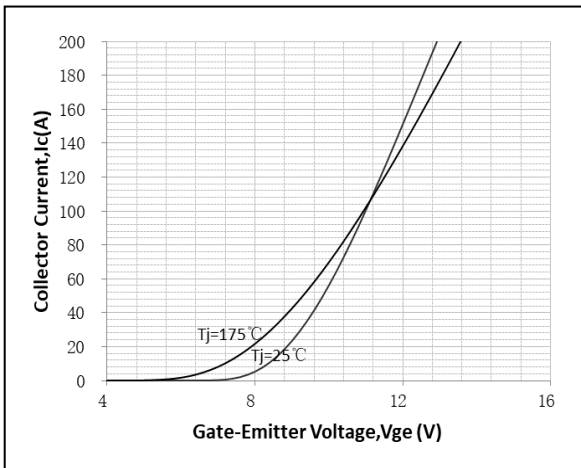
Inverter IGBT output characteristic  
 $I_C = f(V_{CE})$  ( $T_{vj}=25^{\circ}C$ )



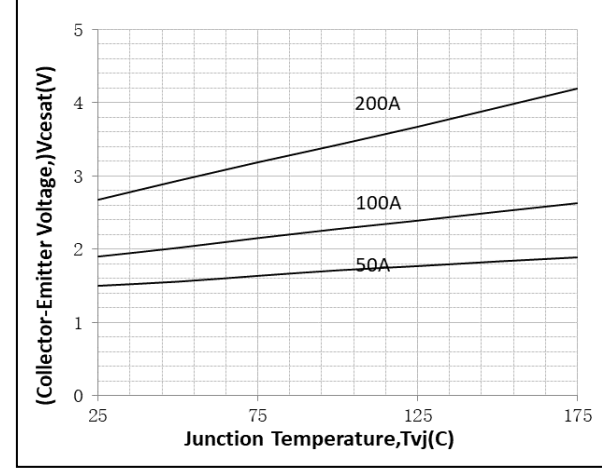
Inverter IGBT output characteristic  
 $I_C = f(V_{CE})$  ( $T_{vj}=150^{\circ}C$ )



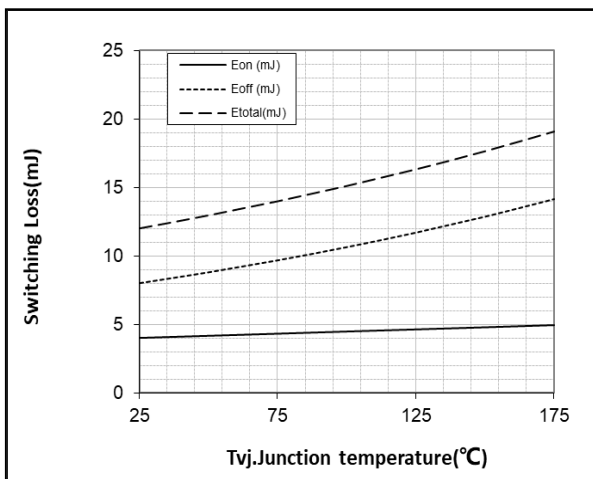
Inverter IGBT Transfer characteristic  
 $I_C = f(V_{ge})$ ,  $V_{CE} = 20V$



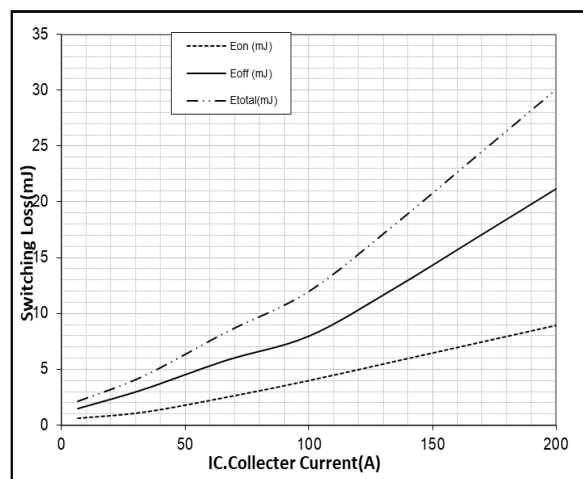
Inverter IGBT Vcesat vs. Tvj



Inverter IGBT Switching Loss vs. Tvj  
 $V_{GE}=15V$ ,  $V_{CE}=600V$ ,  $I_C=100A$



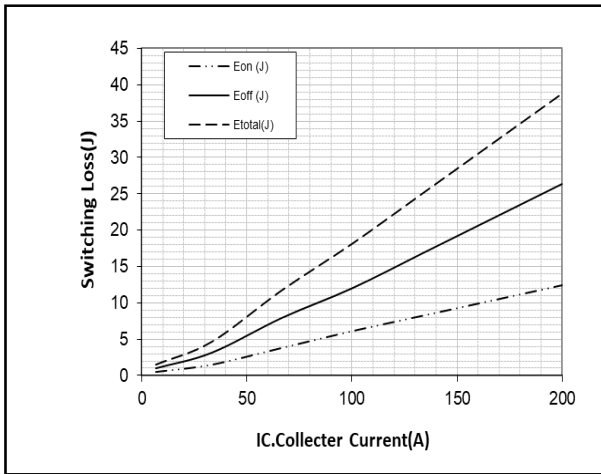
Inverter IGBT Switching Loss vs. IC  
 $T_{vj}=25^{\circ}C$



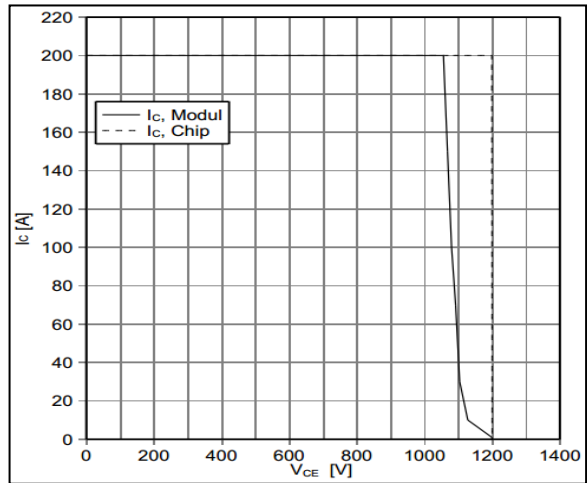


特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

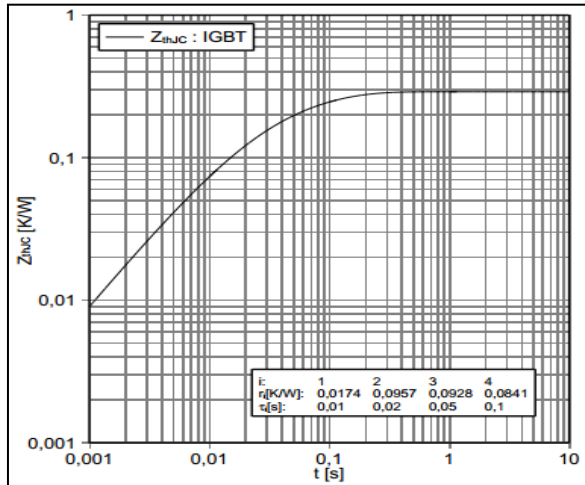
**Inverter IGBT Switching Loss vs. IC**  
Tvj=150°C



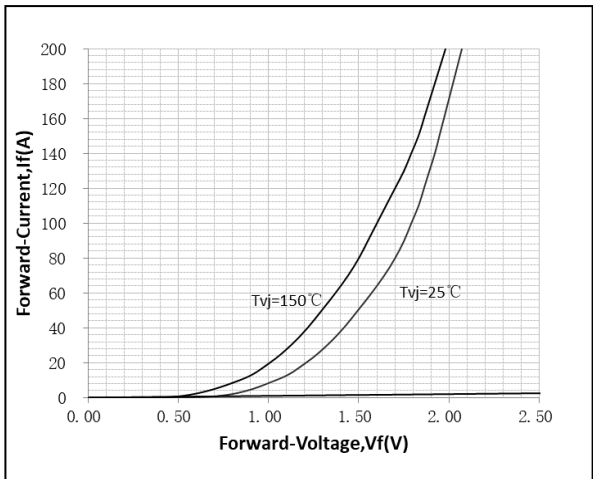
**RBSOA of Inverter IGBT**  
VGE=±15V, Tvj=150°C



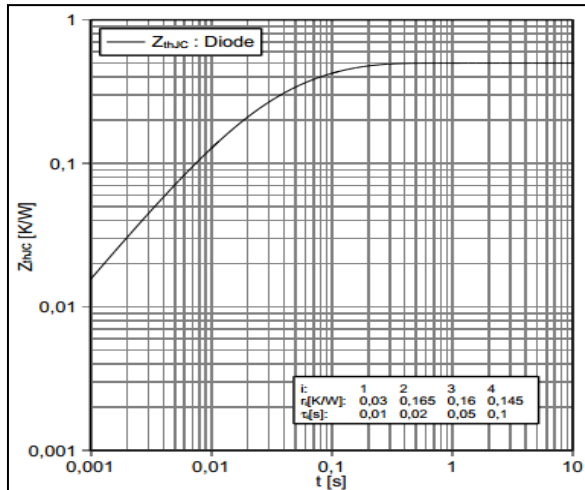
**Inverter IGBT Transient Thermal Impedance**



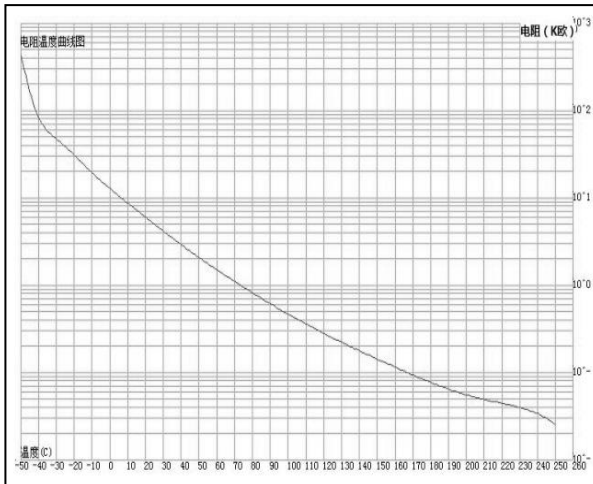
**Inverter FRD Forward Characteristics**



**Inverter FRD Transient Thermal Impedance**



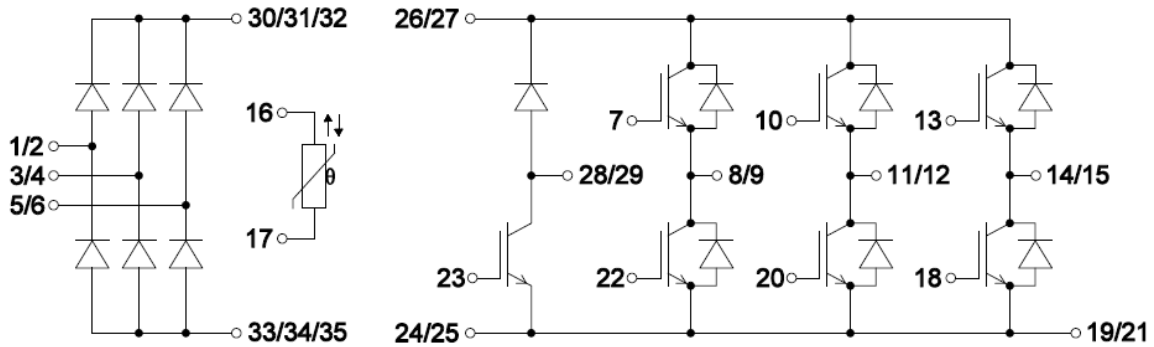
**NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)**





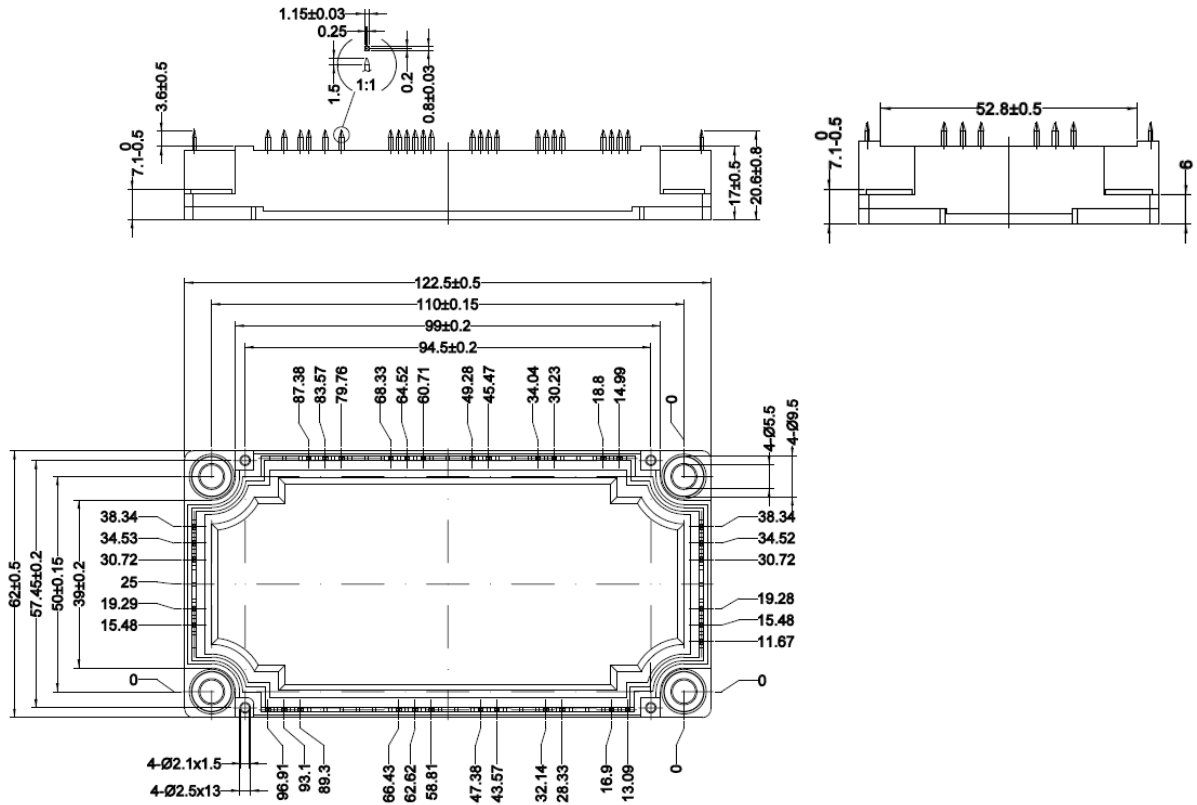
外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

Circuit diagram



Package outlines

单位 Unit: mm





## 注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知。

## NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don't be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this. specification sheet and is subject to change without prior notice.

## 联系方式

### 吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：[www.hwdz.com.cn](http://www.hwdz.com.cn)

## CONTACT

### JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: [www.hwdz.com.cn](http://www.hwdz.com.cn)